

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年7月8日 (08.07.2004)

PCT

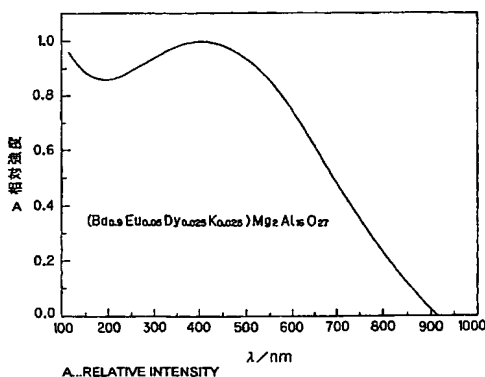
(10) 国際公開番号
WO 2004/056939 A1

- (51) 国際特許分類: C09K 11/08, 11/66, 11/64, 11/62, H01L 33/00 // F21V 8/00, F21Y 101:02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016379
- (22) 国際出願日: 2003年12月19日 (19.12.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 102 59 945.9 2002年12月20日 (20.12.2002) DE
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 豊田合成株式会社 (TOYODA GOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒452-8564 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地 Aichi (JP).
- (72) 発明者: ロットグンドウラ (ROTH, Gundula) [DE/DE]; D-17498 レーフェンハーゲン ドルフシュトラッセ 13アー Levenhagen (DE). テウスヴァルター (TEWS, Walter) [DE/DE]; D-17489 グライフシュバルトルドルフペーターズハーゲン-アレー 12 Greifswald (DE).
- (74) 代理人: 平田 忠雄 (HIRATA, Tadao); 〒102-0075 東京都千代田区三番町1番地13 ワールド・ワイド・センター Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: LUMINESCENT BODY AND OPTICAL DEVICE INCLUDING THE SAME

(54) 発明の名称: 発光体およびこれを用いた光デバイス



(57) Abstract: A luminescent body of prolonged fluorescence lifetime characterized by comprising not only an activator but also at least one coactivator selected from the group consisting of La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Bi, Sn, Sb and analogues thereof as a further luminescence center for enhancing the thermostability of luminescent body. This luminescent body excels in thermostability and fluorescence lifetime, so that it is useful as a luminescent body for LED.

(57) 要約:

本発明は、「付活剤の他に La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn、Sb 及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、発光体の温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含むことを特徴とする長蛍光寿命を有する発光体。」に関する。

本発明は、温度安定性と蛍光寿命に優れるので、LED 用発光体として好適である。



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

発光体およびこれを用いた光デバイス

- 5 本出願は、ドイツ特許出願番号 (DE 1 0 2 5 9 9 4 5. 9) に基づいており、このドイツ出願の全内容は、本出願において参照され導入される。

技術分野

- 10 本発明は、長蛍光寿命を有する発光体およびこれを用いた光デバイスに関し、例えば、オプトエレクトロニック固体構成要素及びコンパクト省エネルギーランプの製造に使用される発光体およびこれを用いた光デバイスに関する。

背景技術

- 15 Butler, K. H. : 「Fluorescent Lamp Phosphors in Technology and Theory (蛍光ランプ蛍光体の技術及び理論)」、ペンシルバニア大学、Press University Park (1980) は、青色及び短波長紫外スペクトル領域の両方で励起でき、且つ可視スペクトル領域で発光する、蛍光ランプ用発光体を開示している。しかしながら、それらは、いままで蛍光ランプ及びコンパクト省エネルギーランプにのみ使
20 用されることしか知られていない。

有機染料と無機染料の両方とも、LEDに使用される。有機染料は、単独では安定性が低く且つ有効性が低い。

- 25 しかしながら、WO 98/12757、WO 02/93116 及び米国特許第 6, 252, 254 号は、白色光を生成するための色変換材としてますます使用される無機材料を開示している。但し、これらは、主にイットリウムアルミニウムガーネットからなる YAG 発光体系に対応させなければならない。この発光体種は、生成される白色光が低演色種であり、例えば、青色 LED とこの黄色光発光体との組み合わせの場合、演色指数 Ra が 70 ~ 77 であり、演色種 I I a であるという欠点がある。これらの白色光の生成品質が不十分であるのは、たとえ 5000 K 未満の色

温度で得られるとしても白色光が不十分にしか得られない楕円形光分布に起因する。しかしながら、YAG発光体系の使用は、青色LEDに制限される。色波長460nm未満では、YAG発光体系の励起性は、激減する。UVLEDの作動範囲である色波長370～400nmでは、YAG発光体系は、限られた程度にしか励起されることができない。

WO00/33389は、色波長500nm未満で刺激する良好な特性をも有する、色波長505nmで極大発光を有する $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 発光体系を記載している。

WO00/33390は、同時演色指数 R_a 83～87で色温度3000～6500Kを生じるLED用発光体混合物を開示している。好ましくは、赤色スペクトル領域又は青色スペクトル領域で発光するさらなる発光体との組み合わせにおいて、発光体を、着色光及び／又は白色光を生成させるための混合物として使用できる。LEDに使用される全ての従来の発光体は、温度特性が不十分であり且つ温度安定性も不十分であるという欠点がある。これにより、LEDの動作時に、発光体の有効性が温度の増加とともに著しく減少する。YAG発光体系の場合と同様に、この場合も、発光のエネルギー分布のシフトが生じて光色変化が生じる。

ある用途についてのさらなる欠点は、バリウムマグネシウムアルミネートからなるCe付活YAG発光体及びEu付活BAM発光体等のLEDに使用される公知の発光体の蛍光寿命が短いことがある。主にCe付活発光体及びEu付活発光体についての典型的な蛍光寿命は、数マイクロ秒である。極大で、蛍光寿命が数ミリ秒のことがあり、これは、例えば、マンガンによる追加のドーピングにより得られる。

本発明の目的は、温度安定性が改善され且つ関連した長蛍光寿命を有する発光体を提供することにある。

更に、本発明の目的は、高光品質、省電力性、および高輝度等の特性に優れる光デバイスを提供することにある。

発明の開示

(A) 本発明により、付活剤の他に、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジウム(Pr)、ネオジウム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(G

d)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ビスマス(Bi)、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、発光体の温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含むことを特徴とする、長蛍光寿命を有する発光体が提供される。

(B) 本発明の他の側面により、

LED素子から放射される光に基づいて励起されて励起光を放射する発光体を含む波長変換部を有する光デバイスにおいて、

前記波長変換部は、付活剤の他に、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ビスマス(Bi)、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含むことを特徴とする光デバイスが提供される。

(C) 本発明の他の側面により、

LED素子と、

前記LED素子を搭載するとともに前記LED素子に給電するための給電部と、
前記LED素子と前記給電部とを一体的に封止する光透過性を有する封止部と、

前記LED素子から放射される光に基づいて励起されて励起光を放射し、付活剤の他に、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ビスマス(Bi)、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含む波長変換部を有することを特徴とする光デバイスが提供される。

(D) 本発明の他の側面により、

LEDランプと、

前記LEDランプから放射される光を導光する導光部と、

前記導光部を介して導光された光に基づいて励起されて励起光を放射し、付活剤の他に、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジ
5 スプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ビスマス(Bi)、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含む波長変換部と、

- 10 前記波長変換部を介して放射される光に基づいて照明される被照明部とを有することを特徴とする光デバイスが提供される。

図面の簡単な説明

- 15 第1図は、本発明の発光体に係る相対強度と加熱温度との関係を示す特性図である。

第2図は、本発明の発光体に係る相対強度と発光スペクトルの関係を示す特性図である。

第3図は、励起エネルギーをスイッチオフした状態での光源における相対強度を示す特性図である。

- 20 第4図は、第1の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

第5図は、第1の実施の形態に係るLED素子の層構成図である。

第6図は、第1の実施の形態に係るLED素子の他の構成を示す層構成図である。

第7図は、第2の実施の形態に係る発光装置を示し、(a)は縦断面図、(b)はLED素子の部分拡大図である。

- 25 第8図は、第3の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

第9図は、第4の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

第10図は、第5の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

第11図は、第6の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

第12図は、第7の実施の形態に係る光デバイスとしての液晶バックライト装置を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

5 以下に、本発明に係る発光体について、図面等を参照して詳細に説明する。

表1に、長蛍光寿命を有する本発明による発光体の一部を、種々の温度でのそれらの相対発光濃度とともに追加して示す。

表 1

発光体組成	相対発光濃度			
	25°C	70°C	100°C	120°C
$(\text{Ba}_{0.9648}\text{Sr}_{0.01}\text{Eu}_{0.025}\text{Dy}_{0.0002})_2(\text{Si}_{0.98}\text{Ge}_{0.02})_3\text{O}_{8.0006}$	100%	100.6%	102.7%	101.5%
$(\text{Ba}_{0.9696}\text{Sr}_{0.015}\text{Ca}_{0.005}\text{Eu}_{0.01}\text{Pr}_{0.0004})_3(\text{Si}_{0.99}\text{Ge}_{0.01})\text{O}_{5.0018}$	100%	102.4%	102.8%	102.0%
$(\text{Ba}_{0.965}\text{Sr}_{0.02}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.01})(\text{Si}_{0.97}\text{Ge}_{0.03})_2(\text{Al}_{0.002}\text{Dy}_{0.00003})\text{O}_{5.003045}$	100%	101.4%	102.0%	101.5%
$(\text{Ba}_{0.905}\text{Sr}_{0.07}\text{Zn}_{0.005}\text{Mg}_{0.005}\text{Eu}_{0.015})_2\text{Si}(\text{Al}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{4.00045}$	100%	101.2%	102.4%	102.3%
$(\text{Ba}_{0.915}\text{Sr}_{0.005}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.075})_3\text{Mg}_{0.99}\text{Mn}_{0.01}(\text{Si}_{0.998}\text{Ge}_{0.002})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0001})\text{O}_{8.0003}$	100%	102.0%	103.6%	102.4%
$(\text{Ba}_{0.92}\text{Sr}_{0.04}\text{Zn}_{0.01}\text{Ca}_{0.01}\text{Eu}_{0.02})_2\text{Mg}(\text{Si}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{7.00045}$	100%	100.6%	101.0%	100.8%
$(\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.05}\text{Dy}_{0.05}\text{Eu}_{0.1})\text{Mg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$	100%	102.8%	107.4%	108.0%
$(\text{Ba}_{0.15}\text{Sr}_{0.8}\text{Eu}_{0.05})_4\text{Al}_{12.5}\text{Ga}_{1.49996}\text{Dy}_{0.00004}\text{Si}_{0.005}\text{O}_{25.0075}$	100%	101.5%	103.5%	103.5%
$(\text{Ba}_{0.47}\text{Sr}_{0.5}\text{Eu}_{0.03})\text{Al}_{1.5997}\text{Ga}_{0.4}\text{Dy}_{0.0003}\text{Si}_{0.004}\text{O}_{4.006}$	100%	100.5%	100.8%	100.6%

(1) 表1の第1行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.9648}\text{Sr}_{0.01}\text{Eu}_{0.025}\text{Dy}_{0.0002})_2(\text{Si}_{0.98}\text{Ge}_{0.02})_3\text{O}_{8.0006}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 Eu_2O_3 、 Dy_2O_3 、 SiO_2 及び GeO_2 である。

調製：

- 5 酸化形態の原料、又は酸化物に転化できる材料からの原料を、表示の化学量論比で混合し、反応条件に応じて、コランダム坩堝中で、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1220℃で4時間か焼する。最終生成物を、水で洗浄し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長487nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

- 10 (2) 表1の第2行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.9696}\text{Sr}_{0.015}\text{Ca}_{0.005}\text{Eu}_{0.01}\text{Pr}_{0.0004})_3(\text{Si}_{0.99}\text{Ge}_{0.01})\text{O}_{5.0018}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 CaCO_3 、 Eu_2O_3 、 Pr_6O_{11} 、 SiO_2 及び GeO_2 である。

調製：

- 15 原料を化学量論比で数時間激しく混合した後、得られた混合物を、コランダム坩堝中で、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1245℃で3時間か焼する。得られたか焼ケーキを粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長589nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

- 20 (3) 表1の第3行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.965}\text{Sr}_{0.02}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.01})(\text{Si}_{0.97}\text{Ge}_{0.03})_2(\text{Al}_{0.002}\text{Dy}_{0.00003})\text{O}_{5.003045}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 ZnO 、 Eu_2O_3 、 SiO_2 、 GeO_2 、 Al_2O_3 及び Dy_2O_3 である。

調製：

- 25 原料を化学量論比で秤量し、数時間均一混合する。得られた混合物を、室温でオープンに入れ、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1220℃で4時間か焼する。得られたか焼物を粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長509nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

- (4) 表1の第4行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.905}\text{Sr}_{0.07}\text{Zn}_{0.005}\text{Mg}_{0.005}\text{Eu}_{0.015})_2\text{Si}(\text{Al}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{4.00045}$ を有する発光体が記載さ

れている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 ZnO 、 Eu_2O_3 、 SiO_2 、 Dy_2O_3 及び Al_2O_3 である。

調製：

表示の原料を上記の化学量論比で混合する。得られた混合物を、還元条件下1220℃の温度で予備か焼する。か焼材料を粉碎後、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1220℃で二次か焼プロセスをおこなう。2時間の二次か焼により、均一な最終生成物が得られ、その後、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長445nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

(5) 表1の第5行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.915}\text{Sr}_{0.005}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.075})_3\text{Mg}_{0.99}\text{Mn}_{0.01}(\text{Si}_{0.998}\text{Ge}_{0.002})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0001})\text{O}_{8.0003}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 ZnO 、 Eu_2O_3 、 MgO 、 MnCO_3 、 SiO_2 、 GeO_2 、 Dy_2O_3 及び Ga_2O_3 である。

調製：

原料を良好に混合後、か焼プロセスに附する。か焼プロセスは、反応条件下、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1225℃で3時間実施する。最終生成物を、粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長543nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

(6) 表1の第6行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.92}\text{Sr}_{0.04}\text{Zn}_{0.01}\text{Ca}_{0.01}\text{Eu}_{0.02})_2\text{Mg}(\text{Si}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{7.00045}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 ZnO 、 CaCO_3 、 Eu_2O_3 、 MgO 、 SiO_2 、 GeO_2 、 Dy_2O_3 及び Ga_2O_3 である。

調製：

原料を化学量論比で完全に激しく混合した後、窒素／水素混合物の還元雰囲気中1235℃で4時間か焼プロセスに附する。最終生成物を、粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長548nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

(7) 表1の第7行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.05}\text{Dy}_{0.05}\text{Eu}_{0.1})\text{Mg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 K_2CO_3 、 Dy_2O_3 、 Eu_2O_3 、 MgO 及び Al_2O_3 である。

調製：

- 5 原料を化学量論比で秤量した後、融剤として AlF_3 をさらに含有する得られた混合物を、窒素／水素混合物の還元雰囲気中 1420°C で2時間か焼する。得られたか焼物を粉碎し、数回水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長 452 nm で極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

- 10 発光体 $(\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.05}\text{Dy}_{0.05}\text{Eu}_{0.1})\text{Mg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$ の相対発光強度（相対強度）と $100\text{ K} \sim 900\text{ K}$ の範囲で加熱温度との関係を、第1図に示す。発光体の相対強度は、 $200\text{ K} \sim$ 約 600 K の温度範囲で 0.8 超である。

- (8) 表1の第8行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.15}\text{Sr}_{0.8}\text{Eu}_{0.05})_4\text{Al}_{12.5}\text{Ga}_{1.49996}\text{Dy}_{0.00004}\text{Si}_{0.005}\text{O}_{25.0075}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 Eu_2O_3 、 Al_2O_3 、 Ga_2O_3 、 SiO_2 及び Dy_2O_3 である。
- 15

調製：

- 表示の原料を化学量論量で秤量した後、融剤としてホウ酸を添加して均一混合し、コランダム坩堝中、窒素／水素混合物の還元雰囲気中 1420°C で2時間か焼する。続いて、得られたか焼物を粉碎し、再び激しく混合し、同条件下でさらにか焼プロセスに附する。次に得られた最終生成物を、粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られる発光体化合物は、色波長 496 nm で極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。
- 20

- (9) 表1の第9行目において、組成 $(\text{Ba}_{0.47}\text{Sr}_{0.5}\text{Eu}_{0.03})\text{Al}_{1.5997}\text{Ga}_{0.4}\text{Dy}_{0.0003}\text{Si}_{0.004}\text{O}_{4.006}$ を有する発光体が記載されている。その原料は、 BaCO_3 、 SrCO_3 、 Eu_2O_3 、 Al_2O_3 、 Ga_2O_3 、 SiO_2 及び Dy_2O_3 である。
- 25

調製：

原料を化学量論比で融剤としてのホウ酸と塩化アンモニウムとともに混合し、窒素／水素混合物の還元雰囲気中 1420°C で2時間か焼する。か焼ケーキを粉碎及び

混合後、か焼プロセスを反復する。最終生成物を、粉碎し、水洗し、乾燥し、篩分けする。得られた化合物は、色波長523 nmで極大発光を示し、長蛍光寿命を有する。

第2図は、図示していない光源1の虹色の発光スペクトルを示す。光源1は、発
5 光体

$(\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.05}\text{Dy}_{0.05}\text{Eu}_{0.1})\text{Mg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$ と、

$(\text{Ba}_{0.965}\text{Sr}_{0.02}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.01})(\text{Si}_{0.97}\text{Ge}_{0.03})_2(\text{Al}_{0.002}\text{Dy}_{0.00003})\text{O}_{5.003045}$ と、

$(\text{Ba}_{0.9696}\text{Sr}_{0.015}\text{Ca}_{0.005}\text{Eu}_{0.01}\text{Pr}_{0.0004})_3(\text{Si}_{0.99}\text{Ge}_{0.01})\text{O}_{5.0018}$ と
10 の混合物を含む。

紫外線波長380 nmでの色の相対発光強度（相対強度）は0.04であり、波
長490 nmでの青色の相対発光強度は0.034であり、波長508 nmでの緑
色の相対発光強度は0.02であり、波長560 nmでの黄色の相対発光強度は0.
15 024であり、波長610 nmでの赤色の相対発光強度は0.02である。

光源1での励起エネルギーをスイッチオフした後も、この光源は、第3図に示す
色波長580 nmに極大発光を有する相対発光強度（相対強度）0.0375の黄
色光をまだ放射する。

（本発明に係る発光体の効果）

20 （1）本発明の発光体によれば、通常に使用される付活剤の他に、ランタン（L
a）、セリウム（Ce）、プラセオジウム（Pr）、ネオジウム（Nd）、サマリウム
（Sm）、ガドリニウム（Gd）、テルビウム（Tb）、ジスプロシウム（Dy）、
ホルミウム（Ho）、エルビウム（Er）、ツリウム（Tm）、イッテルビウム
（Yb）、ルテチウム（Lu）、ビスマス（Bi）、スズ（Sn）、アンチモン
25 （Sb）及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を使用することにより
達成される。共付活剤により、発光体においてさらなる中心が得られ、LEDの場合、
より高い測定動作温度で発光体自体で生じるより少ないエネルギー損失プロセスが
可能となる。目的とするこれらの追加の共付活剤を発光体に含有させることにより、
さらなる及び／又は新しい再結合中心が形成される。

この追加の付活には、蛍光寿命を数秒又は数分、最大数時間まで増加するという利点がある。これにより、とりわけ安全光及び健康光で作業する用途においてますます重要性が増している光源が人間の目の適合挙動へ適合することが可能となる。

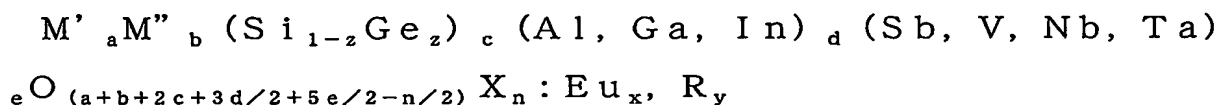
これらの発光体の混合物は、種々の時間の蛍光寿命を実現するのに好適である。

- 5 本発明によれば、これにより、発光体の励起をスイッチオフするとLEDの色を変化させることが可能となる。

これらのさらなる及び新しい中心のさらなる利点は、発光イオンとの放射再結合が原則として可能である主にこれらの中心により、電子が励起状態から捕獲されることである。次に、これらの電子は、キラー中心、すなわち、励起エネルギーが無駄に熱に変換されて発光の損失が生じる中心によっては捕獲されない。

- 10 駄に熱に変換されて発光の損失が生じる中心によっては捕獲されない。

(2) 本発明によれば、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩を含み且つユーロピウムをドーピングすることにより温度安定性及び蛍光寿命を改善した発光体が、実験式



- 15 (式中、

M' は、カルシウム (Ca)、ストロンチウム (Sr)、バリウム (Ba) 及び亜鉛 (Zn) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、マグネシウム (Mg)、カドミウム (Cd)、マンガン (Mn) 及びベリリウム (Be) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

- 20 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、

Xは、電荷のバランスをとるためのフッ素 (F)、塩素 (Cl)、臭素 (Br) からなる群から選択されたイオンであり、

- 及び $0.5 \leq a \leq 8$ であり、 $0 \leq b \leq 5$ であり、 $0 < c \leq 10$ であり、 $0 \leq d \leq 2$ であり、 $0 \leq e \leq 2$ であり、 $0 \leq n \leq 4$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ であり、 $0 \leq z \leq 1$ である)、
- 25

に相当する追加のドーパントを含む、発光体が提供される。

(3) アルミン酸塩-ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムによりドーピングした発光体の場合における温度安定性と蛍光寿命の改善は、実験式

$M'_{14} (Al, Ga)_{14} (Si, Ge)_p O_{25+2p} : Eu_x, R_y$ に相当する追加のドーパント又は実験式

$M' (Al, Ga)_2 (Si, Ge)_p O_{4+2p} : Eu_x, R_y$ に相当する追加のドーパント

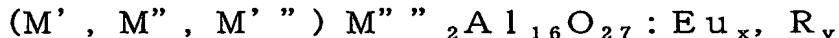
5 (式中、

M' は、Sr、Ba、Ca、Mg及びZnからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、

10 $0 < p \leq 1$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、
により達成される。

(4) アルミン酸塩を含み且つユーロピウムによりドーピングした発光体の場合における温度安定性と蛍光寿命の改善では、実験式



15 (式中、

M' は、Ba、Sr及びCaからなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)及びルビジウム(Rb)からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M''' は、Dyであり、

20 M'''' は、Mg、Mnであり、

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

$0 < x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、

に相当する追加のドーパントにより達成される。

25 (5) アルカリ土類金属アルミン酸塩-ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムをドーピングした発光体の場合の温度安定性と蛍光寿命を改善するために、実験式



(式中、

M' は、Ca、Sr、Ba及びMgからなる群から選択された一種以上の元素であり、

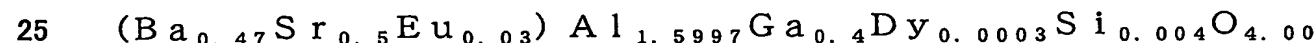
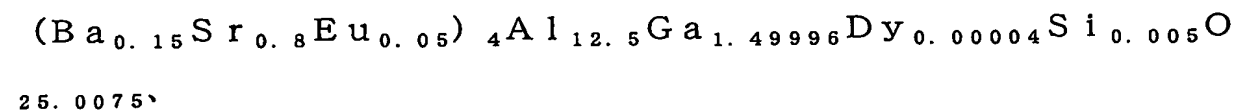
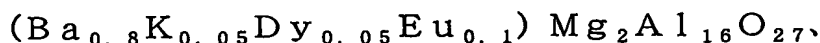
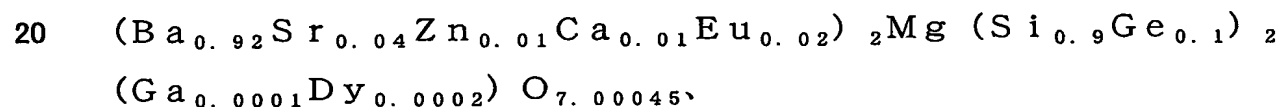
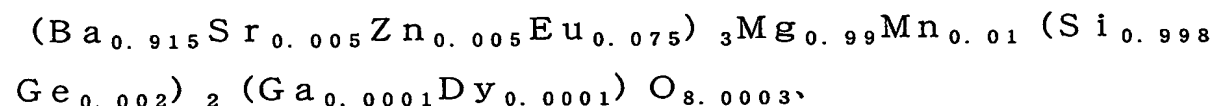
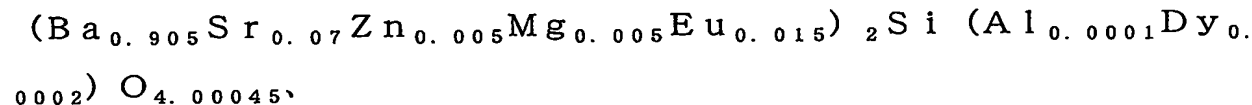
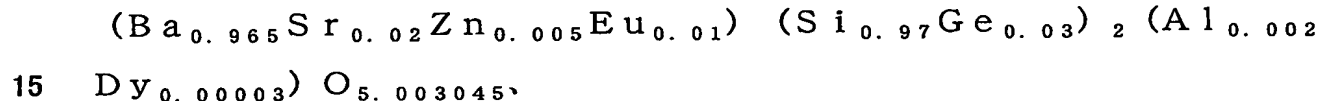
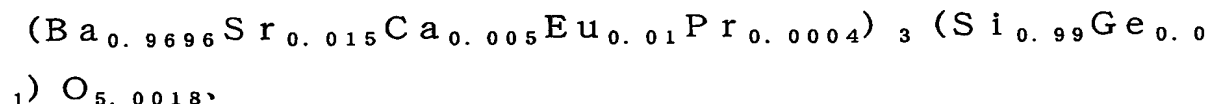
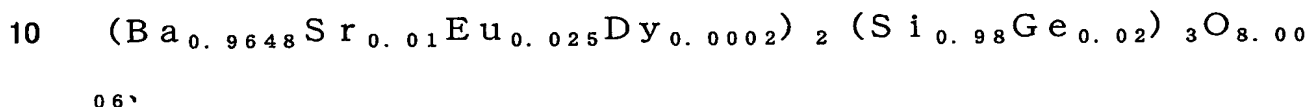
Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、

5 及び

$0 \leq a \leq 1$ であり、 $0 \leq b \leq 10$ であり、 $0 \leq c \leq 8$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ である）、

で表される追加のドーパントでドーピングを実施する。

本発明によれば、これらの発光体、例えば、



6

は、LED又はコンパクト省エネルギーランプにおいて着色～白色光を生成する層に使用される。

(6) 本発明によるケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩発光体を含む発光体混合物及び/又は本発明によるアルミン酸塩-ガリウム酸塩発光体の一種以上を含む発光体混合物は、LED及びコンパクト省エネルギーランプの温度安定性及び蛍光寿命を改善するための層としても好適である。

- 5 さらなる利点として、LEDを動作したときにチップ自体により提供される熱エネルギーにより、これらの中心から電子が自由となり、同時に発光することが可能となることがあげられる。いずれの場合も、発生する熱は、効果的に変換される。

- これにより、発光体の温度安定性を改善でき、従って発光元素に使用するのに有利であり、且つ着色光及び/又は白色光を発生させる特定のLEDに使用するのにも有利である。約60～120℃の動作温度でLEDを動作させるとき、従来の発光体と比較して有効性が改善される。さらに、発光体は、一般的にマイクロ秒の範囲である蛍光寿命を示す従来のLED用発光体と比較して、長蛍光寿命を示す。その特性により、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩発光体は、同時に、可視スペクトルの橙色-赤色スペクトル領域がその組成に依存する限り、青色スペクトル領域からの
10 発光に極めて好適である。特に、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩発光体は、長蛍光寿命を有し、同時に高度の有効性を有する白色光を得るために、波長300～500 nmの範囲における青色及び/又は紫外励起光源用変換材として使用するのに選択される。

- さらなる利点に、これらの中心からの電子が自由になることにより、励起状態が
20 通常存在する他に得られ、励起源を動作すると温度の上昇とともに有効性が増加することがある。

この原理は、青色～赤色スペクトル領域を放出する発光体に適用できる。

- 同時に、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩発光体を単独又はアルミン酸塩-ガリウム酸塩発光体系若しくは他の発光体との組み合わせて使用すると、青色及び/又は紫外
25 LEDによる励起により、長蛍光寿命を有する着色光又は白色光を得ることができる。ケイ酸塩格子におけるゲルマニウム及びアルミン酸塩格子におけるガリウムの両方とも、わずかに格子膨張を生じ、両方の場合とも放出光がわずかにシフトし、蛍光寿命に影響する。このようにして得られた光は、その高蛍光寿命、高温安定性及び高光品質が顕著である。

以下に、上記した発光体を用いた光デバイスを詳細に説明する。

(第1の実施の形態)

第4図は、本発明の第1の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

- この発光装置1は、LED素子をリードに搭載した波長変換型発光装置1であり、
- 5 配線導体であるリード2および3と、リード2に設けられるLED素子收容用のカップ部4と、カップ部4の底部5に接着されたLED素子6と、LED素子6の図示しない電極とリード2および3とを電氣的に接続するAuからなるワイヤ7と、LED素子6およびワイヤ7とともにカップ部4を封止する光透過性の封止樹脂8と、封止樹脂8に混合される発光体9と、光透過性を有してリード2および3とLED素子6とワイヤ7とを一体的に封止する砲弾形状の封止樹脂10とを有する。
- 10

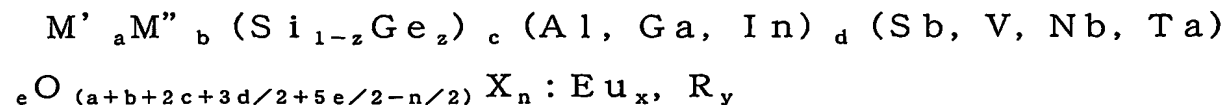
リード2および3は、熱伝導性および導電性に優れる銅又は銅合金によって形成されており、リード3に設けられるカップ部4は、カップ外部への光放射性を高めるために内壁の光出射側を拡大することによって傾斜を有している。

- LED素子6は、波長460nmの青色光を放射するGaN系LED素子であり、
- 15 カップ部4の底部5に光反射性を有する接着材によって接着固定されている。

封止樹脂8は、発光体9を混合されたシリコン樹脂であり、カップ部4にポッティング注入されることによってLED素子6を封止している。

- 発光体9は、通常に使用される付活剤の他に、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジウム(Pr)、ネオジウム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ビスマス(Bi)、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を使用している。
- 20

- 具体的には、封止樹脂8は、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープした発光体に対して、以下の実験式に相当する追加のドーパント
- 25



(式中、

M' は、カルシウム (Ca)、ストロンチウム (Sr)、バリウム (Ba) 及び亜鉛 (Zn) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、マグネシウム (Mg)、カドミウム (Cd)、マンガン (Mn) 及びベリリウム (Be) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

5 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、

Xは、電荷のバランスをとるためのフッ素 (F)、塩素 (Cl)、臭素 (Br) からなる群から選択されたイオンであり、

及び $0.5 \leq a \leq 8$ であり、 $0 \leq b \leq 5$ であり、 $0 < c \leq 10$ であり、 $0 \leq d \leq 2$ であり、 $0 \leq e \leq 2$ であり、 $0 \leq n \leq 4$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ であり、 $0 \leq z \leq 1$ である)、
10 を含む発光体 9 を混合されている。

封止樹脂 10 は、エポキシ樹脂からなり、砲弾形状を形成するための型を用いたキャスティングモールド法によって光出射側に半球状の光学形状を有している。

15 第5図は、LED素子 6 の層構成図である。LED素子 6 は、サファイア基板 61 と、サファイア基板 61 上に形成される AlN バッファ層 62 と、AlN バッファ層 62 上に形成される Si ドープの n 型 GaN クラッド層 (コンタクト層) 63 と、n 型 GaN クラッド層 63 の上に 3 層の InGa N 井戸層 64A と 2 層の GaN 障壁層 64B とを交互に配置して形成される MQW 64 と、MQW 64 上に形成
20 される Mg ドープの p 型 GaN クラッド層 65 と、p 型 GaN クラッド層 65 上に形成される Mg ドープの p 型 GaN コンタクト層 66 と、p 型 GaN コンタクト層 66 上に形成される透明電極 67 と、透明電極 67 上の所定の位置、例えば、素子側面寄りに形成されるパッド電極 68 と、エッチングによって p 型 GaN コンタクト層 66、p 型 GaN クラッド層 65、MQW 64、及び n 型 GaN クラッド層 63 の一部を除去することにより露出した n 型 GaN クラッド層 63 に形成される n
25 側電極 69 とを有する。この LED 素子 6 は発光層として MQW 64 を有するダブルヘテロ構造を有しており、各層に適宜 Al を含む構成とすることも可能である。

次に、発光装置 1 の製造方法について説明する。

まず、リードフレームとなる銅板をプレス加工によって打ち抜くことにより、リード2および3を有するリードフレームを形成する。また、リードフレームの形成時にカップ部4をリード3に形成する。次に、カップ部4内にLED素子6を接着材で接着固定する。次に、LED素子6のパッド電極68とリード2、およびn側電極69とリード3とをワイヤ7で電氣的に接続する。次に、予め発光体9を混合したシリコン樹脂をカップ部4にポッティング注入することによってLED素子6を封止する。次に、樹脂成形用の型にLED素子6を封止されたリード2および3を挿入する。次に、型内にエポキシ樹脂を注入することによりリード2および3の周囲に砲弾形状の封止樹脂10を形成する。次に、リード2および3をリードフレームから切断する。

次に、発光装置1の動作について説明する。

リード2および3を図示しない電源装置に接続して通電することにより、LED素子6のMQW64において発光する。MQW64の発光に基づく光がLED素子6の外部に放射されることにより、発光体9に照射される。発光体9は、LED素子6の放射する光（以下「放射光」という。）によって励起されて励起光を放射する。この放射光と励起光とが混合されることによって白色光がカップ部4の内部で生成される。この白色光は、カップ部4の内部から封止樹脂10を介して外部放射される。また一部の白色光は、カップ部4の傾斜した内壁で反射されて封止樹脂10を介して外部放射される。

上記した第1の実施の形態の発光装置1によると、以下の効果が得られる。

通常に使用される付活剤の他に共付活剤を追加した発光体9を混入された封止樹脂8でカップ部4を封止するようにしたため、発光体の温度安定性が向上し、発光のエネルギー分布のシフトを抑制してLED素子6から放射される光の光色を安定させることができる。

共付活剤を追加することによって蛍光寿命を数秒又は数分、最大数時間まで増加することができるため、とりわけ安全光及び健康光で作業する用途に好適であり、人間の目の適合挙動へ適合させることが可能となる。

共付活剤を追加することによって種々の時間の蛍光寿命を実現できるため、発光体の励起をスイッチオフすると発光装置 1 から放射される光の色を変化させることが可能となる。

また、発光体 9 と他の発光体とを混合して使用することも可能であり、他の発光体として、例えば、YAG を用いることができる。この場合、発光装置 1 をオフすると白色から赤みを含む変化を伴いながら消灯する。具体的には青色系の LED 素子と YAG の発光装置に発光体 9 を組み合わせる構成、紫外系の LED 素子と紫外光で励起される発光体を有した発光装置に発光体 9 を組み合わせる構成でも良い。

なお、第 1 の実施の形態では、ケイ酸塩—ゲルマニウム酸塩を含み且つユーロピウムをドーピングした発光体に対して、上記した追加のドーパントを含む発光体 9 を封止樹脂 8 に混合して用いる構成を説明したが、他の発光体 9 として、アルミン酸塩—ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムによりドーピングした発光体に対して、以下の実験式に相当する追加のドーパント

15 $M'_4 (Al, Ga)_{14} (Si, Ge)_p O_{25+2p} : Eu_x, R_y$ に相当する追加のドーパント又は実験式

$M' (Al, Ga)_2 (Si, Ge)_p O_{4+2p} : Eu_x, R_y$ に相当する追加のドーパント

(式中、

20 M' は、Sr、Ba、Ca、Mg 及び Zn からなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

R は、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn 及び Sb からなる群から選択された一種以上の元素であり、

$0 < p \leq 1$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、を含む発光体 9 を混合されていても良い。

25 また、他の発光体 9 として、アルミン酸塩を含み且つユーロピウムによりドーピングした発光体に対して、以下の実験式に相当する追加のドーパント

$(M', M'', M''') M''''_2 Al_{16} O_{27} : Eu_x, R_y$

(式中、

M' は、Ba、Sr 及び Ca からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、リチウム (Li)、ナトリウム (Na)、カリウム (K) 及びルビジウム (Rb) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

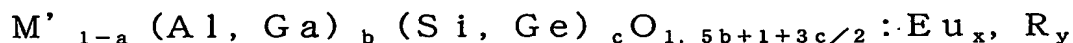
M' は、Dyであり、

M'' は、Mg、Mnであり、

- 5 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び
 $0 < x \leq 0.5$ であり、 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、

を含む発光体9を混合されていても良い。

- また、更に他の発光体9として、アルカリ土類金属アルミン酸塩-ガリウム酸塩
 10 を含み且つユーロピウムをドープした発光体に対して、以下の実験式に相当する追加のドーパント



(式中、

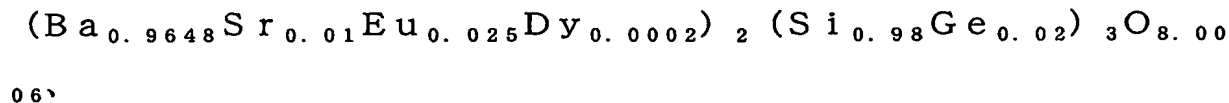
- M' は、Ca、Sr、Ba及びMgからなる群から選択された一種以上の元素で
 15 あり、

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、
 及び

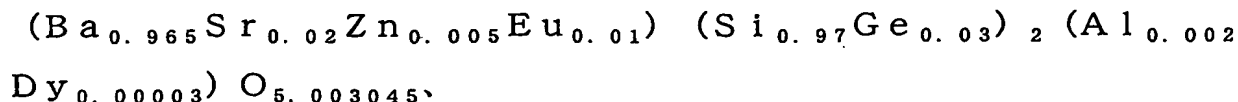
- $0 \leq a \leq 1$ であり、 $0 \leq b \leq 10$ であり、 $0 \leq c \leq 8$ であり、 $0 \leq x \leq 0.5$ であり、
 20 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、

を含む発光体9を混合されていても良い。

また、これらの発光体を組み合わせることにより得られる、例えば、



- 25 $(Ba_{0.9696} Sr_{0.015} Ca_{0.005} Eu_{0.01} Pr_{0.0004})_3 (Si_{0.99} Ge_{0.01}) O_{5.0018},$



$(\text{Ba}_{0.905}\text{Sr}_{0.07}\text{Zn}_{0.005}\text{Mg}_{0.005}\text{Eu}_{0.015})_2\text{Si}(\text{Al}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{4.00045}$ 、

$(\text{Ba}_{0.915}\text{Sr}_{0.005}\text{Zn}_{0.005}\text{Eu}_{0.075})_3\text{Mg}_{0.99}\text{Mn}_{0.01}(\text{Si}_{0.998}\text{Ge}_{0.002})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0001})\text{O}_{8.0003}$ 、

5 $(\text{Ba}_{0.92}\text{Sr}_{0.04}\text{Zn}_{0.01}\text{Ca}_{0.01}\text{Eu}_{0.02})_2\text{Mg}(\text{Si}_{0.9}\text{Ge}_{0.1})_2(\text{Ga}_{0.0001}\text{Dy}_{0.0002})\text{O}_{7.00045}$ 、

$(\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.05}\text{Dy}_{0.05}\text{Eu}_{0.1})\text{Mg}_2\text{Al}_{16}\text{O}_{27}$ 、

$(\text{Ba}_{0.15}\text{Sr}_{0.8}\text{Eu}_{0.05})_4\text{Al}_{12.5}\text{Ga}_{1.49996}\text{Dy}_{0.00004}\text{Si}_{0.005}\text{O}_{25.0075}$ 、

10 $(\text{Ba}_{0.47}\text{Sr}_{0.5}\text{Eu}_{0.03})\text{Al}_{1.5997}\text{Ga}_{0.4}\text{Dy}_{0.0003}\text{Si}_{0.004}\text{O}_{4.006}$

は、LED又はコンパクト省エネルギーランプにおいて着色～白色光を生成する層に使用することができる。

また、LED素子6外部への光放射性を高めるものとして、MQW64に対して
15 サファイア基板61側に光反射層を設けるようにしても良い。具体的には、サファイア基板61上に光反射層としてAl層を設けることができる。

第6図は、LED素子6の他の構成を示す層構成図である。このLED素子6は、
基板としてGaN基板70を用いるとともに、第5図で説明したAlNバッファ層
を省いた構成としたものである。このようなGaN基板70上にGaN系半導体層
20 を結晶成長させることによって形成されたLED素子6を用いることもできる。また、Si、SiC、AlGaN等の材料からなる基板を用いたLED素子6を光源として用いるようにしても良い。

(第2の実施の形態)

第7図は、本発明の第2の実施の形態に係る発光装置を示し、(a)は縦断面図、
25 (b)はLED素子の部分拡大図である。なお、第1の実施の形態の各部に対応する部分には同一符号を付している。

この発光装置1は、光源としてフリップチップ型のLED素子11を用いており、
第7図(a)に示すようにLED素子11とAuバンプ12Aおよび12Bを介して電氣的に接合されるSiからなるサブマウント部13と、サブマウント部13を

リード15Aのカップ部15aに電氣的に接続する導電性接着材であるAgペースト14と、サブマウント部13とワイヤを介して電氣的に接続されるリード15Bと、リード15Aに設けられる素子収容部15Cと、素子収容部15Cに設けられて傾斜を有した光反射面15bとを有する。

- 5 LED素子11は、第7図(b)に示すように光透過性を有するサファイア基板110と、AlNバッファ層111と、n型GaNクラッド層112と、3層のInGaN井戸層と2層のGaN障壁層とを交互に配置して形成されるMQW113と、p型GaNクラッド層114と、p型GaNコンタクト層115と、エッチングによってp型GaNコンタクト層115、p型GaNクラッド層114、MQW113、及びn型GaNクラッド層112の一部を除去することにより露出したn
10 型GaNクラッド層112に形成されるn側電極116と、p型GaNコンタクト層115上に形成されるp側電極117とを有し、基板側がカップ部15aの開口側に配置されるようにサブマウント部13に固定されている。

- サブマウント部13は、第7図(b)に示すようにn型半導体層134の表面に
15 設けられるn側電極130と、n型半導体層134の一部に設けられるp型半導体層131と、p型半導体層131上に設けられるp側電極132と、n型半導体層134の底面側、すなわち、カップ部15aとの接合側に設けられるn側電極133とを有し、n側電極130はAuバンプ12Aを介してLED素子11のp側電極117と接続されている。また、p側電極132はAuバンプ12Bを介してL
20 ED素子11のn側電極116に接続されるとともにワイヤ7が接続されている。

封止樹脂8は、第1の実施の形態で説明した発光体9が混合されており、LED素子11およびサブマウント部13を覆って封止するようにカップ部15aにポッティング注入されている。

- LED素子11をカップ部15a内に固定するには、まず、カップ部15aの底
25 部15cにAgペースト14を塗布する。次に、サブマウント部13をAgペースト14でカップ部15a内に固定する。次に、Auバンプ12Aおよび12Bを介してLED素子11を搭載し、超音波接合を行ってLED素子11をサブマウント部13に接合する。次に、p側電極132とリード15Bとをワイヤで電氣的に接

続する。次に、LED素子11およびサブマウント部13を覆うように封止樹脂8をカップ部15aに注入して封止する。

このようにしてカップ部15aが封止されたリード15Aおよび15Bに対し、封止樹脂10を砲弾形状にモールドする。

- 5 上記した第2の実施の形態の発光装置1によると、第1の実施の形態の好ましい効果に加えてMQW113の発光に基づく光をサファイア基板側から放射させることができるため、光取り出し性が向上する。また、サブマウント部13に静電気に対する保護機能を付与することも可能であり、この場合には静電気によるLED素子11の破壊を防ぐこともできる。

10 (第3の実施の形態)

第8図は、本発明の第3の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。

- この発光装置1は、砲弾形状の封止樹脂10の表面に第1および第2の実施の形態で説明した発光体9を含むエポキシ等の樹脂材料からなるキャップ状の発光体層18を設けており、カップ部15aを封止する封止樹脂8から発光体9を省いた構成として
15 成としている。

- 上記した第3の実施の形態の発光装置1によると、第1および第2の実施の形態の好ましい効果に加えて、LED素子11の周囲に発光体9が堆積することがないため、堆積した蛍光体の光吸収に伴う外部放射効率の低下を防止できる。このこと
20 によって封止樹脂10の表面に効率良く導かれた光を発光体層18で波長変換して外部放射させることができ、高輝度の波長変換型発光装置1が得られる。

(第4の実施の形態)

第9図は、本発明の第4の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。なお、第1から第3の実施の形態の各部に対応する部分には同一符号を付している。

- この発光装置1は、表面実装型の波長変換型発光装置1であり、LED素子11
25 と、LED素子11から放射される光に基づいて励起される発光体層18を含む波長変換部19と、アクリル等の樹脂材料によって形成される本体20と、LED素子11を搭載するセラミック基板21とを有する。

波長変換部19は、低融点ガラスからなる2枚のガラスシートの間第1から第3の実施の形態で説明した発光体9からなる発光体層18を挟み込み、加熱処理を

施すことで一体化したものである。具体的には、第1のガラスシート的一方の面に発光体9をスクリーン印刷し、これを150℃で加熱処理することによりバインダー成分を除去して薄膜化する。この薄膜化された発光体層18を挟み込むように第2のガラスシートを配置して加熱処理を行うことにより第1および第2のガラスシートを一体化する。

本体20は、内部に光反射面15bを有し、LED素子11から放射された光を波長変換部19の方向に反射する光反射面15bを有し、光出射面と波長変換部19の表面とが同一面を形成するように形成されている。また、光反射面15bによって包囲される空間にはシリコン樹脂16が充填されている。

セラミック基板21は、表面にLED素子11をAuバンプ12Aおよび12Bを介して接合するための銅箔パターンである配線層21Aおよび21Bを有し、配線層21Aおよび21Bはセラミック基板21の側面を介して外部回路との接合面である裏面にかけて設けられている。

上記した第4の実施の形態の発光装置1によると、第1から第3の実施の形態の好ましい効果に加えて、発光体9からなる薄膜状の発光体層18をガラス封止しているため、蛍光体層18の耐水性、耐吸湿性が向上し、長期にわたって波長変換性の良好な発光装置1が得られる。

また、発光体層18をスクリーン印刷および加熱処理に基づいて薄膜状に形成しているため、発光体層18による光吸収ロスを低減でき、高輝度の波長変換型発光装置1を実現できる。

また、発光体層18の薄膜化によって発光体9の使用量を低減できるため、発光装置1のコストダウンを実現することができる。

(第5の実施の形態)

第10図は、本発明の第5の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。なお、第1から第4の実施の形態の各部に対応する部分には同一符号を付している。

この発光装置1は、フリップチップ型(0.3×0.3mm)のLED素子11と、LED素子11を搭載するA1Nからなるサブマウント部13と、サブマウント部13と接合されるリードフレーム22Aおよび22Bと、LED素子11およびサブマウント部13を封止するとともにLED素子11から放射される光を波長

変換する低融点ガラスからなる波長変換部 19 と、波長変換部 19 とともにサブマウント部 13、リードフレーム 22A および 22B とを一体的に封止する低融点ガラスからなるガラス封止部 23 とを有し、波長変換部 19 は、LED 素子 11 から放射される光を配光制御する光学形状、すなわち、ドーム状を有するように形成され、
5 されるとともに LED 素子 11 と所定の間隔を隔てて配置された発光体層 18 を有している。

サブマウント部 13 は、表面に銅箔による配線層 21A および 21B が形成されており、リードフレーム 22A および 22B に設けられる段部 22a および 22b に嵌合することによって配線層 21A および 21B がリードフレーム 22A および
10 22B に電氣的に接続されている。

波長変換部 19 は、第 4 の実施の形態で説明した第 1 および第 2 のガラスシート間に発光体層 18 を挟み込んだものを加熱プレスすることによって光学形状を形成している。また、加熱プレス時に同時にガラス封止部 23 を形成する第 3 のガラスシートを加熱処理することによりリードフレーム 22A および 22B を一体的に
15 封止している。発光体層 18 は、ガラスの熱処理に基づく変形に伴って LED 素子 11 との間にガラスシートの厚さに応じた間隔を有して配置される。

上記した第 5 の実施の形態の発光装置 1 によると、第 1 から第 4 の実施の形態の好ましい効果に加えて、波長変換部 19 が光学形状を有しているため、LED 素子 11 から放射される光と発光体層 18 で波長変換された光との混合された光を所望
20 の範囲に放射させることができる。

また、LED 素子 11 がガラス封止されることによって耐水性、耐吸湿性が向上するため、多湿条件等の過酷な環境条件下でも長期にわたって安定した高輝度の波長変換型発光装置 1 が得られる。

(第 6 の実施の形態)

25 第 11 図は、本発明の第 6 の実施の形態に係る発光装置を示す断面図である。なお、第 1 から第 5 の実施の形態の各部に対応する部分には同一符号を付している。

この発光装置 1 は、第 5 の実施の形態のリードフレーム 22A および 22B に代えて、両面に銅箔からなる配線層 24A、24B、25A、および 25B を形成されたセラミック基板 21 を用いており、配線層 24A と 25A、および配線層 24

Bと25Bとをスルーホール26で電氣的に接続している。また、配線層24A、24Bには、Auパンプ12Aおよび12Bを介してフリップチップ型(1×1mm)のLED素子11が電氣的に接続されている。

5 配線層24Aおよび24Bは、波長変換部19を構成するガラス材が接着される面積より大なる面積を有するように形成されている。

上記した第6の実施の形態の発光装置1によると、第1から第5の実施の形態の好ましい効果に加えて、波長変換部19がセラミック基板21の表面に設けられる銅箔からなる配線層24Aおよび24Bと接着されるため、ガラス材と銅箔との良好な接着性に基づいて波長変換部19と配線層24Aおよび24Bとの優れた接着性10が得られる。このことにより、波長変換部19の剥離や発光装置1内部への吸湿を強固に防ぐことができ、信頼性に優れる波長変換型発光装置1が得られる。

また、セラミック基板21を用いることによって、ベースとなる基板材料に一括的に形成された発光装置群をダイシングやスクライプ等の切断加工によって容易に切り出すことができるため、生産性に優れる波長変換型発光装置1が得られる。

15 (第7の実施の形態)

第12図は、本発明の第7の実施の形態に係る光デバイスとしての液晶バックライト装置を示す断面図である。なお、第1から第6の実施の形態の各部に対応する部分には同一符号を付している。

20 この液晶バックライト装置30は、光源であるLEDランプ31と、LEDランプから放射された光を導光する導光体32と、導光体32の表面に設けられてLEDランプ31から放射された光を波長変換する発光体層18と、波長変換光に基づいて背面から透過照明される液晶パネル35とを有する。

LEDランプ31は、GaN系半導体層からなるLED素子の発光に基づく波長460nmの青色光を砲弾形状の樹脂封止部で集光して所定の照射範囲に放射する。

25 導光体32は、LEDランプ31から入射する光を直角方向に反射する反射面32Aと、底面32Bと、反射面32Aで反射されて導光体32内を導光された光が入射する傾斜面32Cとを有し、底面32Bには光反射層33が設けられている。また、傾斜面32Cには、通常に使用される付活剤の他に、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn、Sb、

及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を使用した発光体からなる発光体層 18 が薄膜状に設けられている。

液晶パネル 35 は、例えば、TFT (Thin Film Transister) 基板、液晶層、カラーフィルタ基板を積層して構成されており、導光体 32 から放射される光を透過させる光透過性を有する。

この液晶バックライト装置 30 によると、LED ランプ 31 の放射光を導光体 32 を介して傾斜面 32C に導光し、傾斜面 32C に設けられる発光体層 18 で LED ランプ 31 の放射光を白色光に波長変換して液晶パネル 35 を透過照明する。

上記した第 7 の実施の形態の液晶バックライト装置 30 によると、第 1 から第 6 の実施の形態で説明した好ましい効果に加えて、導光体 32 を介して導光された光を液晶バックライト装置 30 の背面側に設けられる発光体層 18 で波長変換して放射させるようにしたため、青色光を光源として良好な輝度が得られるとともに、蛍光寿命の長い透過照明構造を実現でき、携帯電話や液晶表示部を有する機器の照明装置として、斬新な視覚性を付与することができる。

また、発光体層 18 の蛍光寿命が大であるため、LED ランプ 31 の発光制御との組み合わせに基づいて光品質を低下させることなく省電力化を実現でき、バッテリー等の電源を使用する機器の使用可能時間を大にすることができる。

なお、第 7 の実施の形態では、LED ランプ 31 の放射光を反射面 32A で反射して導光体 32 を導光する構成としたが、反射面 32A を設けない構成とすることもできる。例えば、反射面 32A に代えて底面 32B と直角な光入射端面を形成し、導光体 32 に対する放射光の光入射方向と導光方向とが同一の方向となるようにすることができる。

また、LED ランプ 31 として、青色光を放射するものの他に紫外光を放射するものを用いることも可能である。

産業上の利用の可能性

以上説明したように、本発明によれば、通常に使用される付活剤の他に、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn、Sb、及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を用いたため、

発光体の温度安定性が改善される。従って、発光のエネルギー分布のシフトが生じにくくなり、光色変化の発生を抑制することができる。また、蛍光寿命を数マイクロ秒オーダーから数秒又は数分にまで長寿命化することができる。

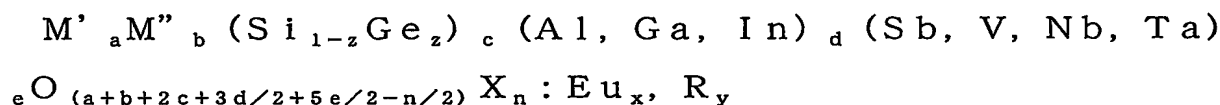
- また、温度安定性および蛍光寿命特性と向上した発光体を用いたため、高光品質、
- 5 省電力性、および高輝度等の特性に優れる光デバイスを提供することができる。

請求の範囲

1. 付活剤の他に、ランタン (L a)、セリウム (C e)、プラセオジウム (P r)、ネオジウム (N d)、サマリウム (S m)、ガドリニウム (G d)、テルビウム (T b)、ジスプロシウム (D y)、ホルミウム (H o)、エルビウム (E r)、ツリウム (T m)、イッテルビウム (Y b)、ルテチウム (L u)、ビスマス (B i)、スズ (S n)、アンチモン (S b) 及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、発光体の温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含むことを特徴とする、長蛍光寿命を有する発光体。

10

2. ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープすることにより温度安定性を増加させた前記発光体が、実験式



15 (式中、

M' は、カルシウム (C a)、ストロンチウム (S r)、バリウム (B a) 及び亜鉛 (Z n) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、マグネシウム (M g)、カドミウム (C d)、マンガン (M n) 及びベリリウム (B e) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

20 Rは、L a、C e、P r、N d、S m、G d、T b、D y、H o、E r、T m、Y b、L u、B i、S n 及び S b からなる群から選択された一種以上の元素であり、

Xは、電荷のバランスをとるためのフッ素 (F)、塩素 (C l)、臭素 (B r) からなる群から選択されたイオンであり、

及び

25 0. $5 \leq a \leq 8$ であり、

$0 \leq b \leq 5$ であり、

$0 < c \leq 10$ であり、

$0 \leq d \leq 2$ であり、

$0 \leq e \leq 2$ であり、

$0 \leq n \leq 4$ であり、

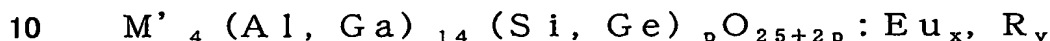
$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ であり、

$0 \leq z \leq 1$ である)、

- 5 に相当する追加のドーパントを含むことを特徴とする、請求の範囲1に記載の長蛍光寿命を有する発光体。

3. アルミン酸塩-ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープすることにより温度安定性を増加させた前記発光体が、実験式



(式中、

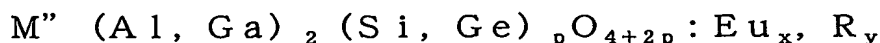
M' は、Sr、Ba、Ca、Mg及びZnからなる群から選択された一種以上の元素であり、

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、

- 15 Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

$0 < p \leq 1$ であるか、

又は実験式



- 20 (式中、

M'' は、Sr、Ba、Ca、Mg及びZnからなる群から選択された一種以上の元素であり、

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、

Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、

- 25 及び

$0 < p \leq 1$ であり、

$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ である)、

に相当する追加のドーパントを含むことを特徴とする、請求の範囲 1 に記載の長蛍光寿命を有する発光体。

4. アルミン酸塩を含み且つユーロピウムをドープすることにより温度安定性を増

5 加させた前記発光体が、実験式 $(M', M'', M''') M''''_2 Al_{16} O_{27} : Eu_x, R_y$ (式中、

M' は、Ba、Sr 及び Ca からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、リチウム (Li)、ナトリウム (Na)、カリウム (K) 及びルビジウム (Rb) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

10 M''' は、Dy であり、

M'''' は、Mg、Mn であり、

R は、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn 及び Sb からなる群から選択された一種以上の元素であり、及び $0 < x \leq 0.5$ であり、

15 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、

に相当する追加のドーパントを含むことを特徴とする、請求項 1 に記載の長蛍光寿命を有する発光体。

5. アルカリ土類金属アルミン酸塩－ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープ

20 することにより温度安定性を増加させた前記発光体が、実験式

$M'_{1-a} (Al, Ga)_b (Si, Ge)_c O_{1.5b+1+3c/2} : Eu_x, R_y$ (式中、

M' は、Ca、Sr、Ba 及び Mg からなる群から選択された一種以上の元素であり、

25 R は、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn 及び Sb からなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

$0 \leq a \leq 1$ であり、

$0 \leq b \leq 10$ であり、

$0 \leq c \leq 8$ であり、

$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ である) 、

に相当する追加のドーパントを含むことを特徴とする、請求の範囲 1 に記載の長蛍
5 光寿命を有する発光体。

6. 前記発光体を、単独又は複数の発光体の混合物として使用することを特徴とす
る、請求の範囲 1 から 5 のいずれかに記載の長蛍光寿命を有する発光体。

10 7. 前記発光体を、LED の調製において発光層として使用することを特徴とする、
請求の範囲 1 から 6 のいずれかに記載の長蛍光寿命を有する発光体。

8. 前記発光体を、LED において着色光～白色光を発生する層に使用することを
特徴とする、請求の範囲 1 から 7 のいずれかに記載の長蛍光寿命を有する発光体。

15

9. 前記発光体を、発光層の励起エネルギーをスイッチオフすると放射線の放出の
色変化を生じさせる LED に使用することを特徴とする、請求の範囲 1 から 8 のい
ずれかに記載の長蛍光寿命を有する発光体。

20 10. 前記発光体を、単独又は複数の発光体の混合物として、コンパクト省エネル
ギーランプにおける発光層の調製に使用することを特徴とする、請求の範囲 1 から
6 のいずれかに記載の長蛍光寿命を有する発光体。

25 11. LED 素子から放射される光に基づいて励起されて励起光を放射する発光体
を含む波長変換部を有する光デバイスにおいて、

前記波長変換部は、付活剤の他に、ランタン (La)、セリウム (Ce)、プラ
セオジウム (Pr)、ネオジウム (Nd)、サマリウム (Sm)、ガドリニウム (G
d)、テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、ホルミウム (Ho)、エル
ビウム (Er)、ツリウム (Tm)、イッテルビウム (Yb)、ルテチウム (L

u)、ビスマス (B i)、スズ (S n)、アンチモン (S b) 及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含むことを特徴とする光デバイス。

5 1 2. LED素子と、

前記LED素子を搭載するとともに前記LED素子に給電するための給電部と、
前記LED素子と前記給電部とを一体的に封止する光透過性を有する封止部と、
前記LED素子から放射される光に基づいて励起されて励起光を放射し、付活剤
10 の他に、ランタン (L a)、セリウム (C e)、プラセオジム (P r)、ネオジム
(N d)、サマリウム (S m)、ガドリニウム (G d)、テルビウム (T b)、ジ
スプロシウム (D y)、ホルミウム (H o)、エルビウム (E r)、ツリウム (T
m)、イッテルビウム (Y b)、ルテチウム (L u)、ビスマス (B i)、スズ
(S n)、アンチモン (S b) 及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤
を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含む波長
15 変換部を有することを特徴とする光デバイス。

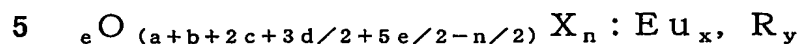
1 3. LEDランプと、

前記LEDランプから放射される光を導光する導光部と、

前記導光部を介して導光された光に基づいて励起されて励起光を放射し、付活剤
20 の他に、ランタン (L a)、セリウム (C e)、プラセオジム (P r)、ネオジム
(N d)、サマリウム (S m)、ガドリニウム (G d)、テルビウム (T b)、ジ
スプロシウム (D y)、ホルミウム (H o)、エルビウム (E r)、ツリウム (T
m)、イッテルビウム (Y b)、ルテチウム (L u)、ビスマス (B i)、スズ
(S n)、アンチモン (S b) 及び類似の物質から選択された一種以上の共付活剤
25 を、温度安定性を向上させるためのさらなる発光中心として含む発光体を含む波長
変換部と、

前記波長変換部を介して放射される光に基づいて照明される被照明部とを有する
ことを特徴とする光デバイス。

14. 前記波長変換部は、ケイ酸塩-ゲルマニウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープされるとともに、以下の実験式



(式中、

M' は、カルシウム (Ca)、ストロンチウム (Sr)、バリウム (Ba) 及び亜鉛 (Zn) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

10 M'' は、マグネシウム (Mg)、カドミウム (Cd)、マンガン (Mn) 及びベリリウム (Be) からなる群から選択された一種以上の元素であり、

R は、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn 及び Sb からなる群から選択された一種以上の元素であり、

X は、電荷のバランスをとるためのフッ素 (F)、塩素 (Cl)、臭素 (Br) からなる群から選択されたイオンであり、

15 及び

0. $5 \leq a \leq 8$ であり、

$0 \leq b \leq 5$ であり、

$0 < c \leq 10$ であり、

$0 \leq d \leq 2$ であり、

20 $0 \leq e \leq 2$ であり、

$0 \leq n \leq 4$ であり、

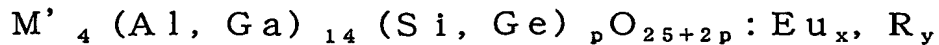
$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ であり、

$0 \leq z \leq 1$ である)、

25 に相当する追加のドーパントを含む発光体を含むことを特徴とする、請求の範囲 1 から 13 のいずれかに記載の光デバイス。

15. 前記波長変換部は、アルミン酸塩-ガリウム酸塩を含み且つユーロピウムをドープされるとともに、以下の実験式



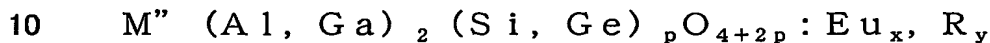
(式中、

M' は、Sr、Ba、Ca、Mg及びZnからなる群から選択された一種以上の元素であり、

- 5 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

$0 < p \leq 1$ であるか、

又は実験式



(式中、

M'' は、Sr、Ba、Ca、Mg及びZnからなる群から選択された一種以上の元素であり、

- 15 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び

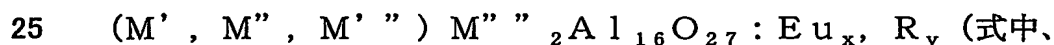
$0 < p \leq 1$ であり、

$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ である)、

- 20 に相当する追加のドーパントを含む発光体を含むことを特徴とする、請求の範囲11から13のいずれかに記載の光デバイス。

16. 前記波長変換部は、アルミン酸塩を含み且つユーロピウムをドーブされるとともに、以下の実験式



M' は、Ba、Sr及びCaからなる群から選択された一種以上の元素であり、

M'' は、リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)及びルビジウム(Rb)からなる群から選択された一種以上の元素であり、

M''' は、Dyであり、

M'' は、Mg、Mnであり、

Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、及び
 $0 < x \leq 0.5$ であり、

5 $0 \leq y \leq 0.5$ である)、

に相当する追加のドーパントを含む発光体を含むことを特徴とする、請求の範囲1
 1から13のいずれかに記載の光デバイス。

17. 前記波長変換部は、アルカリ土類金属アルミン酸塩－ガリウム酸塩を含み且
 10 つユーロピウムをドープされるとともに、以下の実験式



(式中、

M' は、Ca、Sr、Ba及びMgからなる群から選択された一種以上の元素であり、

15 Rは、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sn及びSbからなる群から選択された一種以上の元素であり、
 及び

$0 \leq a \leq 1$ であり、

$0 \leq b \leq 10$ であり、

20 $0 \leq c \leq 8$ であり、

$0 \leq x \leq 0.5$ であり、

$0 \leq y \leq 0.5$ である)、

に相当する追加のドーパントを含む発光体を含むことを特徴とする、請求の範囲1
 1から13のいずれかに記載の光デバイス。

25

18. 前記波長変換部は、前記LED素子を封止する光透過性を有した封止樹脂に
 含まれることを特徴とする、請求の範囲12に記載の光デバイス。

19. 前記発光体は、前記光透過性を有するガラスによって封止される薄膜状の発光体層であることを特徴とする、請求の範囲12に記載の光デバイス。

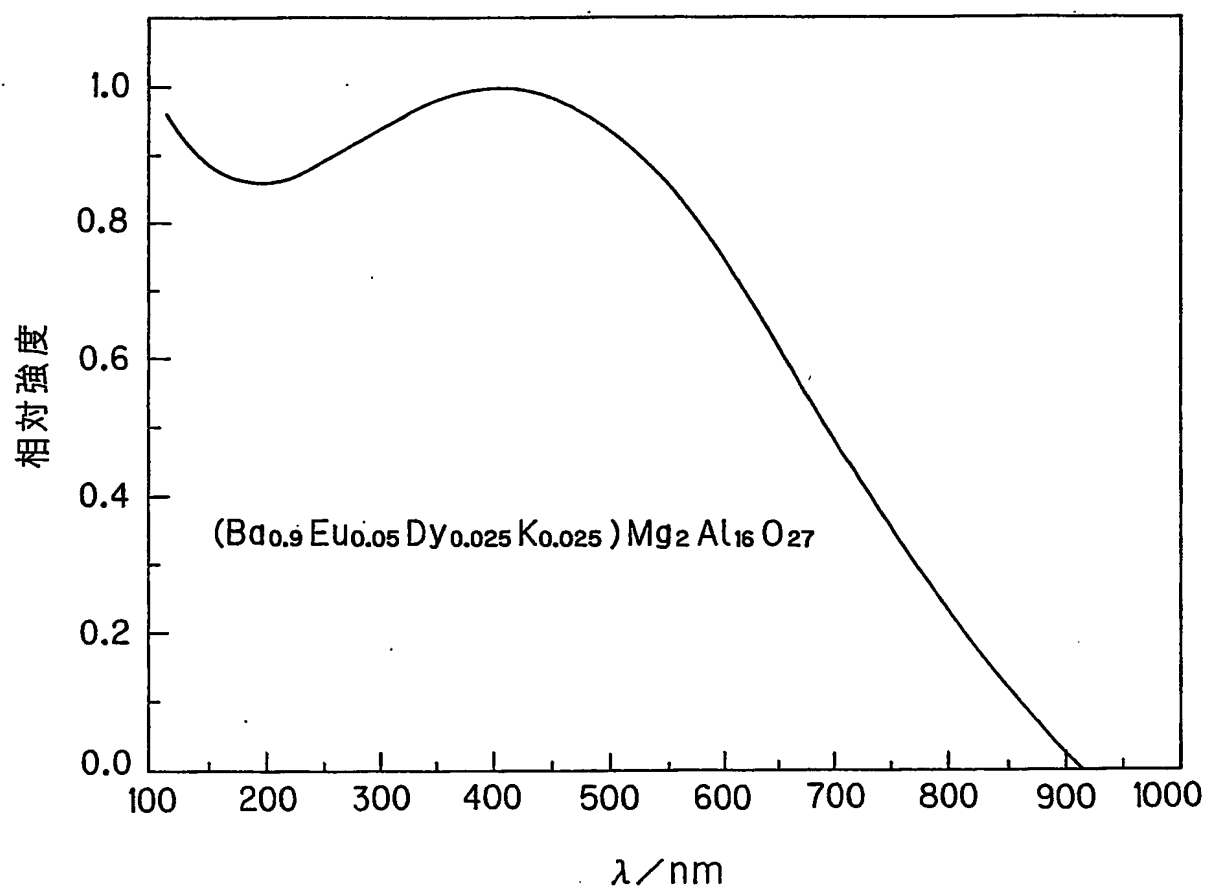
20. 前記発光体層は、面状に形成されていることを特徴とする、請求の範囲19
5 に記載の光デバイス。

21. 前記波長変換部は、前記LED素子から放射される光を所望の照射範囲に放射させる光学形状を有した封止樹脂の表面に設けられることを特徴とする、請求の
10 範囲12に記載の光デバイス。

22. 前記波長変換部は、波長300nmから500nmの範囲における青色光及び／又は紫外光によって励起されることを特徴する、請求の範囲11から13のい
ずれかに記載の光デバイス。

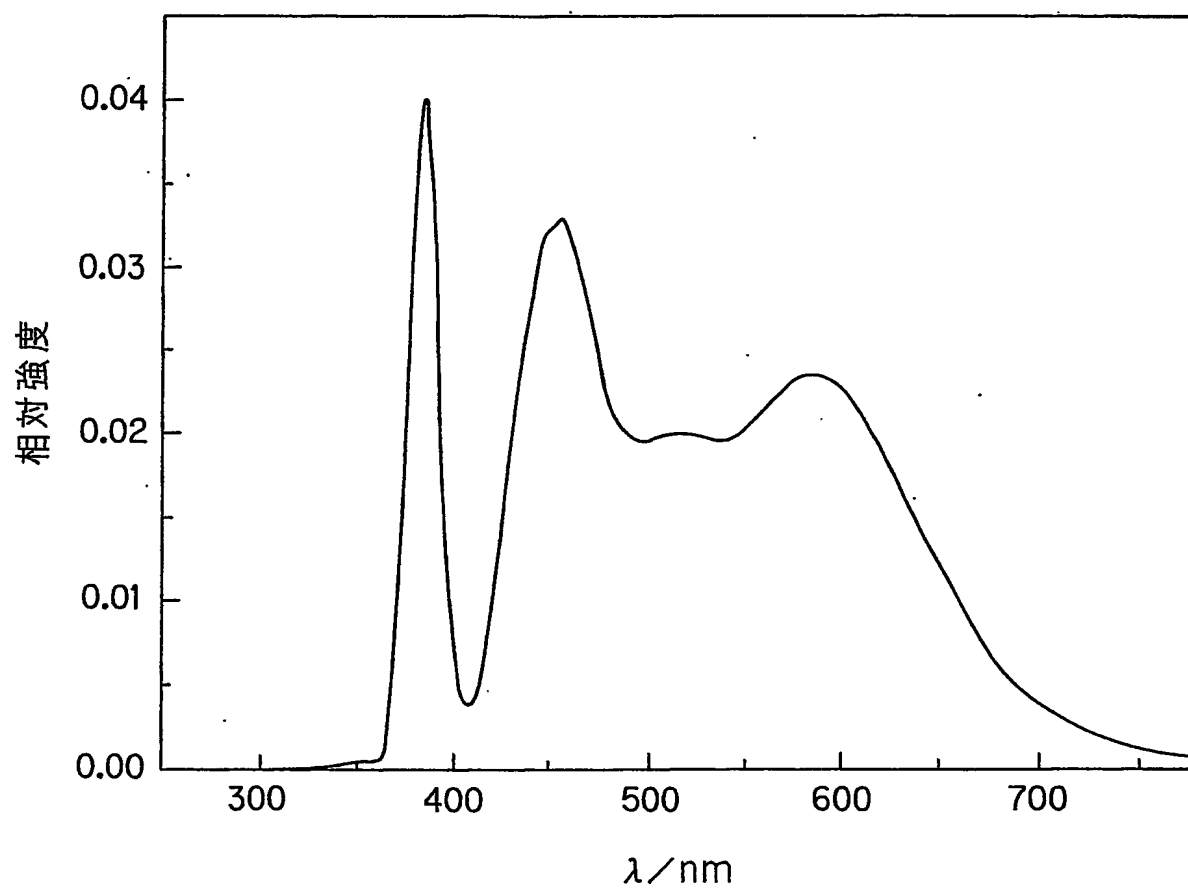
1/9

第 1 図



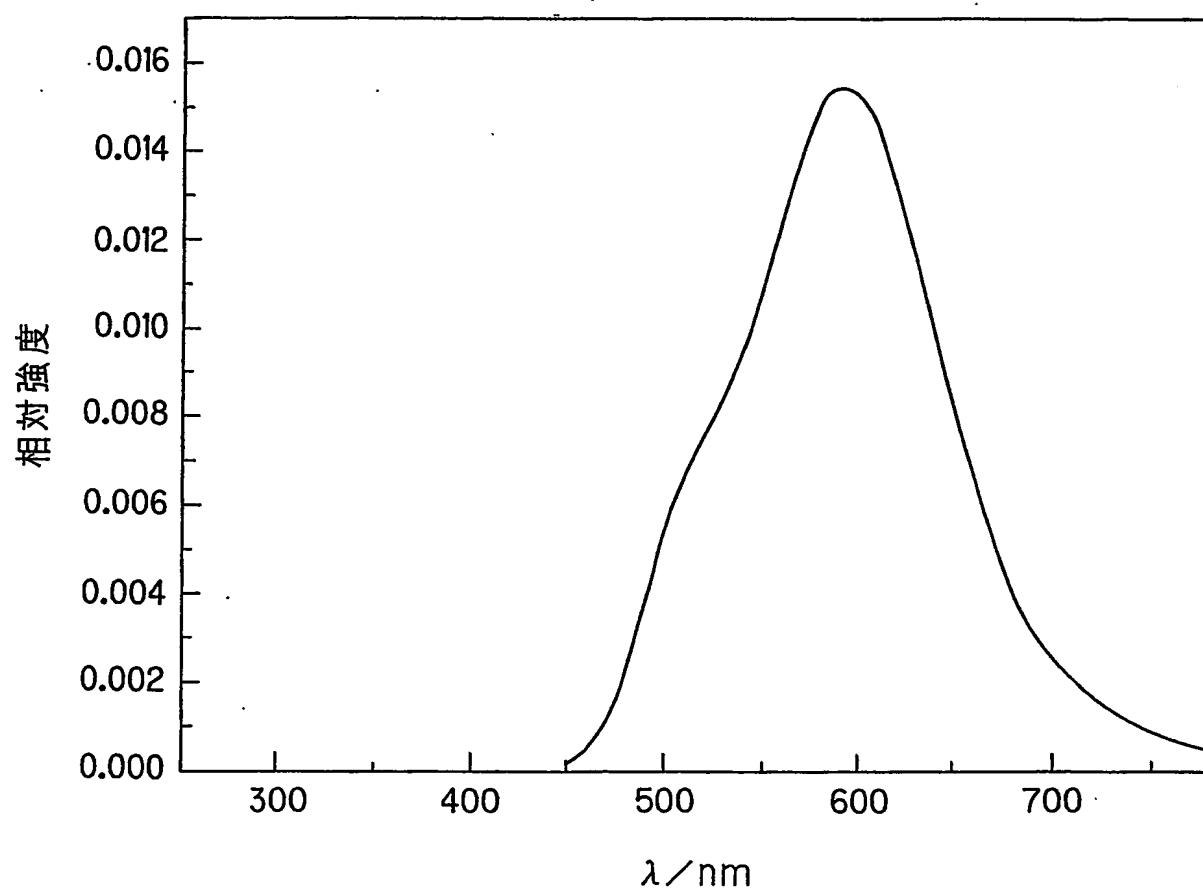
2/9

第 2 図



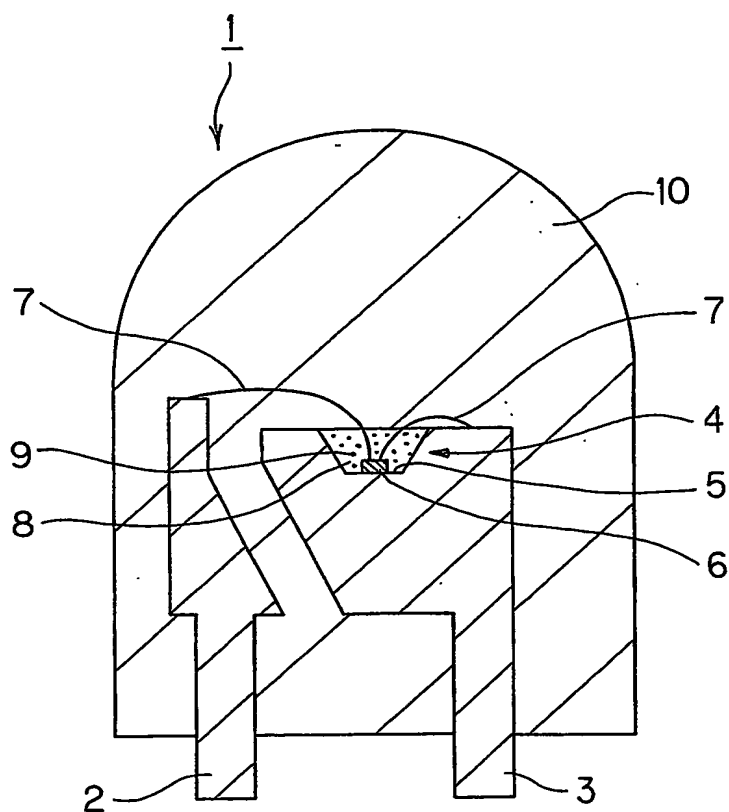
3/9

第 3 図



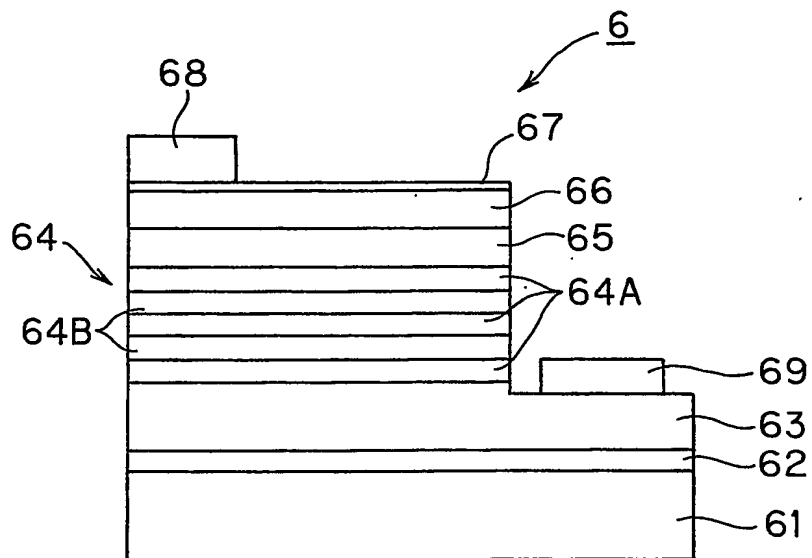
4/9

第 4 図

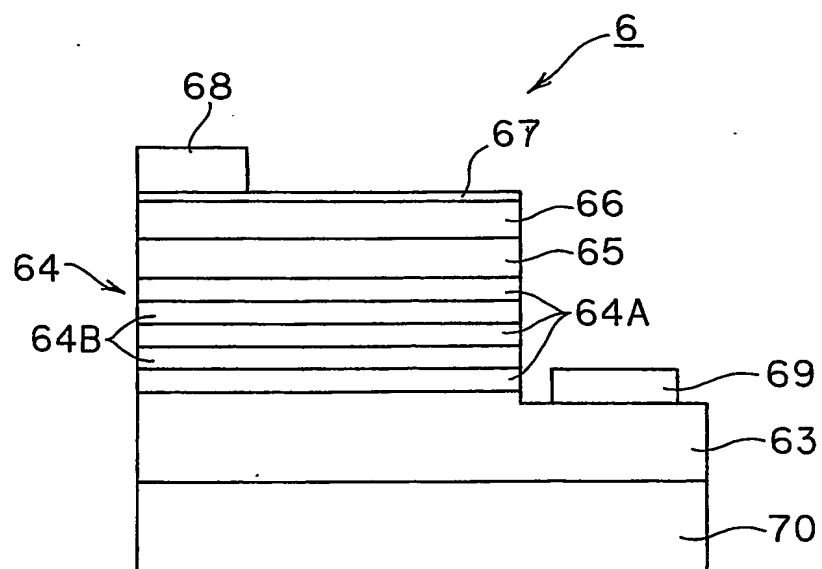


5/9

第 5 図

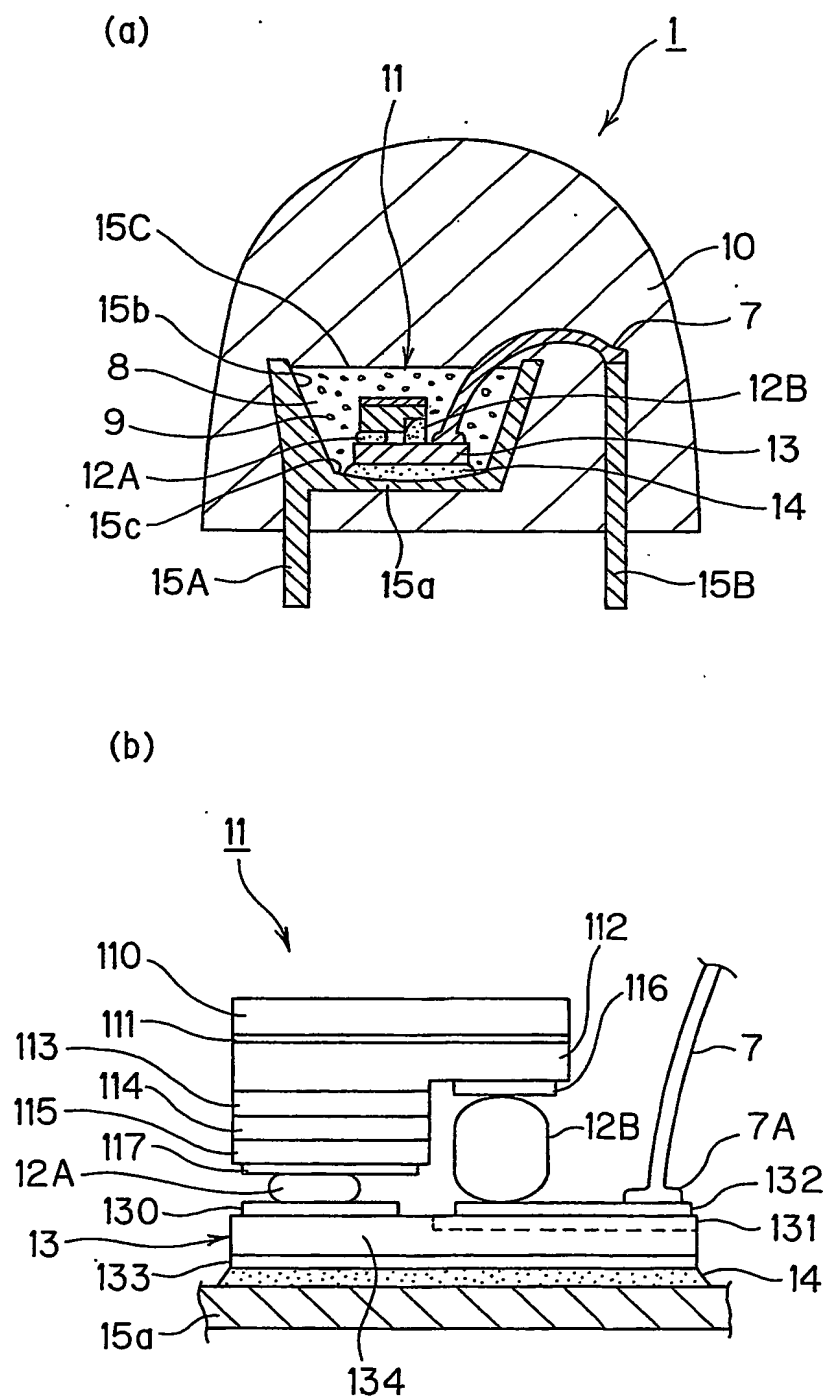


第 6 図



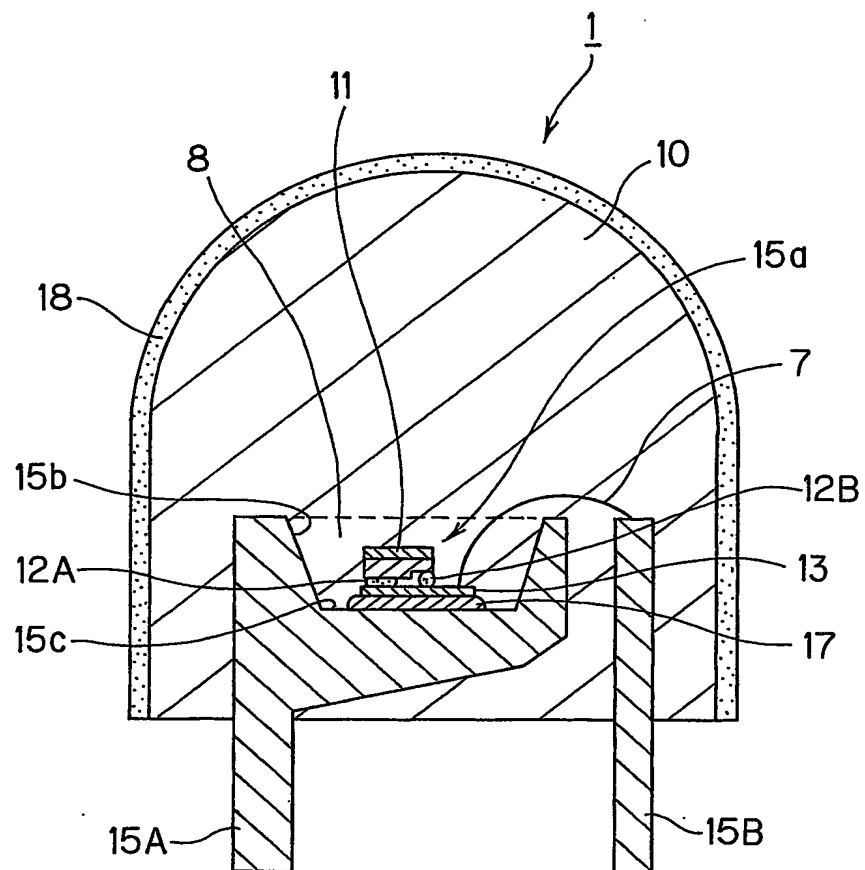
6/9

第 7 図



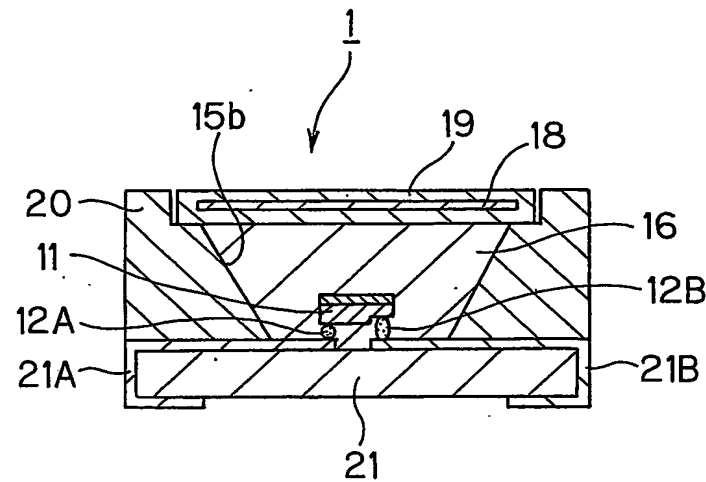
7/9

第 8 図

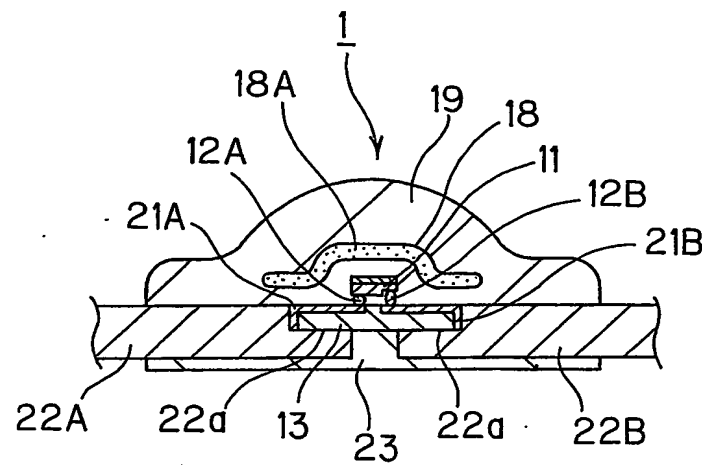


8/9

第 9 図

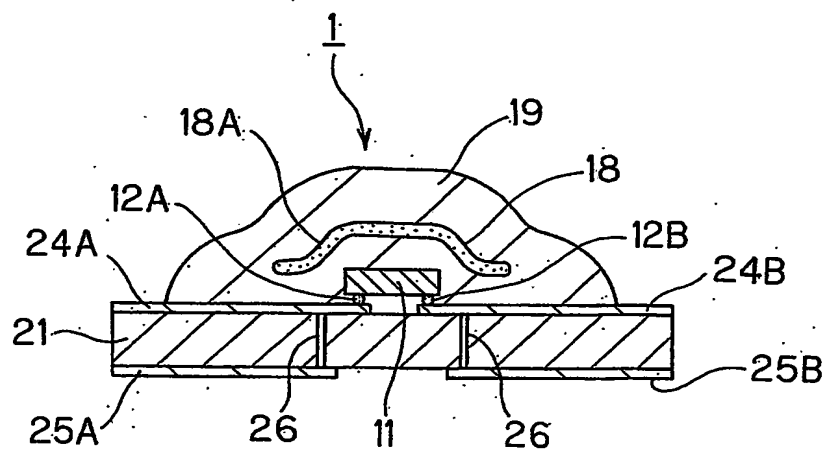


第 10 図

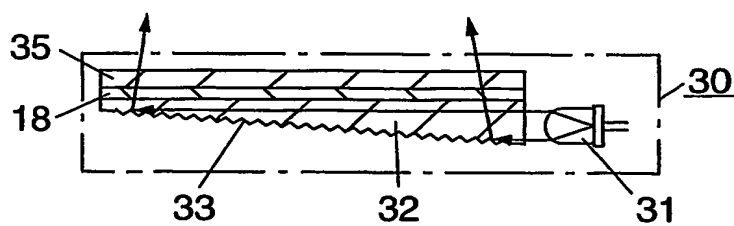


9/9

第 11 図



第 12 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16379

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C09K11/08, C09K11/66, C09K11/64, C09K11/62, H01L33/00//
F21V8/00, F21Y101:02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C09K11/08-11/89, H01L33/00, F21V8/00, F21Y101:02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/0180338 A1 (NANTEX INDUSTRY CO., LTD.), 05 December, 2002 (05.12.02), Claims	1, 6, 7, 9-13, 18-22
A	& JP 2002-363555 A Claims	2-3, 5, 14, 15, 17
X	EP 1264873 A2 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE), 11 December, 2002 (11.12.02), Claims	1, 6-13, 18-22
	& JP 2002-363554 A Claims	

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
16 February, 2004 (16.02.04)

Date of mailing of the international search report
02 March, 2004 (02.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/16379

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 10-112557 A (Nichia Chemical Industries, Ltd.), 28 April, 1998 (28.04.98), Claims; Par. No. [0001] (Family: none)	1, 6-13, 18-22
X	US 2002/0063301 A1 (Sharp Corp.), 30 May, 2002 (30.05.02), Claims & JP 2002-171000 A Claims 1, 6, 8, 25	1, 6-13, 18-22
X	WO 97/27267 A1 (Kasei Optonix, Ltd.), 31 July, 1997 (31.07.97), Claims; examples & JP 9-194833 A Claims; table 1-2	2, 6, 10
A	WO 2001/089001 A1 (General Electric Co.), 22 November, 2001 (22.11.01), Abstract & JP 2004-501512 A Abstract	4, 16

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C09K11/08, C09K11/66, C09K11/64, C09K11/62, H01L33/00 // F21V8/00, F21Y101:02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C09K11/08-11/89, H01L33/00, F21V8/00, F21Y101:02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 2002/0180338 A1 (NANTEX INDUSTRY CO., LTD.) 2002. 12. 05 特許請求の範囲 & JP 2002-363555 A 特許請求の範囲	1, 6, 7, 9-13, 18-22
A		2-3, 5, 14, 15, 17
X	EP 1264873 A2 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) 2002. 12. 11 特許請求の範囲 & JP 2002-363554 A 特許請求の範囲	1, 6-13, 18-22
X	JP 10-112557 A (日亜化学工業株式会社) 1998. 04. 28 特許請求の範囲、段落0001 (ファミリーなし)	1, 6-13, 18-22

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 02. 2004

国際調査報告の発送日

02. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

藤原 浩子

4 V

9155

電話番号 03-3581-1101 内線 3483

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 2002/0063301 A1 (シャープ 株式会社) 2002. 05. 30 特許請求の範囲 & JP 2002-171000 A 請求項1, 6, 8, 25	1, 6-13, 18-22
X	WO 97/27267 A1 (化成オプトニクス株式会社) 1997. 07. 31 特許請求の範囲、実施例& JP 9-194833 A 特許請求の範囲、表1-2	2, 6, 10
A	WO 2001/089001 A1 (ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ) 2001. 11. 22 要約 & JP 2004-501512 A 要約	4, 16